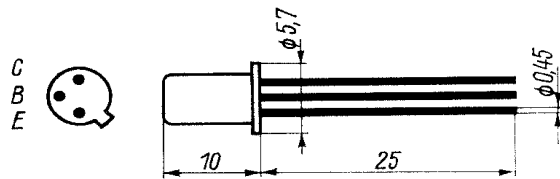


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Verstärker, Misch- und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 1 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	$= 15 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$= 10 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C$	$= 15 \text{ mA}$
Emitterstrom	I_E	$= 15 \text{ mA}$
Basisstrom	$-I_B$	$= 5 \text{ mA}$
Gesamtverlustleistung	P_V	$= 50 \text{ mW}$ bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C}$
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	$= +75^\circ \text{C}$
Betriebstemperaturbereich		-25°C bis $+65^\circ \text{C}$

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$1,5 \mu\text{A}$	$15 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$80 \mu\text{A}$	$500 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 25 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEO}$		$40 \mu\text{A}$	$600 \mu\text{A}$
$U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		$40 \mu\text{A}$	$500 \mu\text{A}$
$-U_{EB} = 15 \text{ V}$				

Dynamische Kennwerte

Grenzfrequenz	f_{h21b}	1 MHz	2,1 MHz	
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
$-I_C = 1 \text{ mA}$				
$f = 3 \text{ MHz}$				
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21e}	18		35
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$		28		56
$-I_C = 2 \text{ mA}$		45		90
$f = 1 \text{ kHz}$		71		140
		112		224
Rauschmaß	F		14 dB	25 dB
$-U_{CE} = 1 \text{ V}$				
$-I_C = 0,2 \text{ mA}$				
$f = 1 \text{ kHz}$				
$\Delta f = 1 \text{ kHz}$				
$R_o = 500 \Omega$				
Vierpolparameter	h_{11e}	0,2 k Ω	0,6 k Ω	5 k Ω
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$	h_{12e}		$4 \cdot 10^{-4}$	$30 \cdot 10^{-4}$
$-I_C = 2 \text{ mA}$	h_{22e}		$56 \mu\text{S}$	$200 \mu\text{S}$
$f = 1 \text{ kHz}$				

Stromverstärkungsgruppe

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe d

Transistor GC 100 d